

точно удовлетворительным во мн. случаях, но все-таки лишь приближённым способом описания явлений, происходящих в оптич. системах. Более детальное рассмотрение микроструктуры И. о., принимающее во внимание волновую природу света, показывает, что изображение точки даже в идеальной (безаберрац.) системе представляет собой не точку, а сложную дифракц. картину (подробнее см. в ст. *Разрешающая способность оптич. приборов*).

Для оценки качества И. о., получившей большое значение в связи с развитием фотогр., телевиз. и пр. методов, существенно распределение плотности световой энергии в изображении. С этой целью используют особую характеристику — контраст $K = (E_{\max} - E_{\min}) \times \frac{1}{(E_{\max} + E_{\min})}$, где E_{\max} и E_{\min} — наименьшее и наибольшее значение освещённости в И. о. стандартного тест-объекта; за такой объект обычно принимают решётку, яркость к-рой меняется по синусоидальному закону с частотой R (число периодов решётки на 1 мм). Контраст K зависит от R и направления штрихов решётки. Ф-ция $K(R)$ наз. частотно-контрастной характеристикой. Чем меньше K при заданной R , тем хуже качество И. о. в данной системе.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., т. 1, М.—Л., 1948; Слюсарев Г. Г., Методы расчета оптических систем, 2 изд., Л., 1969, гл. 10; Маршаль А., Франсон М., Структура оптического изображения, пер. с франц., М., 1964. Г. Г. Слюсарев.

ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОД — один из методов решения краевых задач матем. физики (для *Гельмгольца уравнения*, *Пуассона уравнения*, *волнового уравнения* и др.), заключающийся в сведении исходной задачи отыскания поля заданных (сторонних) источников в присутствии граничных поверхностей к расчёту поля тех же и нек-рых добавочных (фiktивных) источников в безграничной среде. Последние помещаются вне области отыскания поля исходной задачи и наз. источниками-изображениями. Их величина и положение определяются формой граничных поверхностей и видом граничных условий.

К классу задач, разрешимых с помощью И. м., относятся обычно те, в к-рых каждому заданному точечному источнику удаётся сопоставить конечную систему (нек-рый бесконечный дискретный ряд) однотипных точечных источников-изображений. Существует достаточно простой способ «конструирования» задач этого класса с заранее известным ответом. Он состоит в решении обратной задачи отыскания поверхности, на к-рой выполняется требуемое граничное условие для поля нек-рой произвольно заданной системы точечных источников (разграждаемых искомой поверхностью на сторонние и фiktивные). Однако ценность большинства построенных таким способом решений оказывается весьма ограниченной из-за осуществляющей в них жёсткой фиксации положения сторонних источников по отношению к граничной поверхности. Лишь в немногих случаях, отвечающих нек-рым простейшим формам границы и типам граничных условий, решение может быть построено при произвольном расположении сторонних источников, а следовательно, на основании принципа суперпозиции, и для любого вида их пространственного распределения. Наиб. известные из таких случаев описаны ниже применительно к полям и источникам разл. типов.

В электростатике, где И. м. получил наиб. развитие, простейшим примером его использования является определение поля точечного заряда q , расположенного над бесконечной плоской границей проводника с потенциалом $\phi=0$. Искомое поле (в том полупространстве, где расположен заряд) тождественно полю, создаваемому в безграничной среде двумя точечными зарядами: данным зарядом q и его (взятым с обратным знаком) зеркальным (относительно границы) изображением $q'=-q$.

Если поверхность проводника представляет собой сферу S радиуса a , а заряд q лежит в точке P на рас-

стоянии OP от её центра O , то как внутр. задача ($OP < \langle a \rangle$), так и внеш. задача для засемлённого шара ($OP > a$, $\phi(S)=0$) решаются с помощью единственного заряда-изображения q' , помещаемого в точку P' , лежащую на одной радиальной прямой P по др. сторону от границы S . Величина заряда q' и его расстояние до центра OP' даются соотношениями: $q' = -qa/OP$, $OP' = a^2/OP$, т. е. P и P' связаны преобразованием инверсии относительно сферы S . Система изображений для незаряж. изолированного шара состоит из заряда q' в инверсной точке P' и заряда $q'' = -q'$ в центре O . Подобный вид имеет решение аналогичной двумерной задачи (заряж. нить, параллельная оси проводящего цилиндра). Отличие от сферы состоит в том, что абс. величины заданного и фiktивного линейных зарядов одинаковы. В ряде случаев оказывается возможным построить систему изображений для проводящих поверхностей, представляющих собой комбинацию рассмотренных простейших форм. Сюда относятся, в частности, двугранный угол величины π/m (где m — целое число), две параллельные плоскости (порождающие бесконечный ряд зарядов-изображений), плоскость с полусферич. выступом и т. д.

Известны две задачи, в к-рых И. м. позволяет найти поле зарядов, расположенных около границы диэлектрика. Первая задача — о поле точечного заряда q , лежащего в точке P над плоскостью S , разделяющей две среды (1 и 2) с разл. диэлектрич. проницаемостями ϵ_1 и ϵ_2 . Поле в той среде, где находится заряд (пусть для определённости это будет среда 1), ищется как суперпозиция полей двух зарядов q и q' в однородном диэлектрике с $\epsilon=\epsilon_1$; заряд q' лежит в точке P' , представляющей собой зеркальное изображение точки P относительно границы S . Поле в среде 2 ищется как поле заряда q'' в однородном диэлектрике с $\epsilon=\epsilon_2$; заряд q'' лежит в той же точке P , что и заданный заряд q . Граничные условия на S для потенциала ϕ и его нормальной производной $\partial\phi/\partial n$

$$\Phi_1 = \Phi_2, \quad \epsilon_1 \frac{\partial \Phi_1}{\partial n} = \epsilon_2 \frac{\partial \Phi_2}{\partial n} \quad (1)$$

будут выполнены, если

$$q' = q \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}, \quad q'' = q \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}. \quad (2)$$

Аналогичным образом строится решение второй задачи, заключающейся в расчёте поля двумерной системы, образованной заряж. нитью и диэлектрич. цилиндром.

На основании известных аналогий получаемые с помощью И. м. решения при сопоставимых граничных условиях могут быть перенесены из электростатики в др. области: токовую статику, магнитостатику, гидродинамику. В частности, заменив в (2) диэлектрич. проницаемости на магнитные, получаем закон изображения магн. полюсов в плоской границе магнетика, легко обобщаемый затем на «магн. листки» и эквивалентные им токи. При $\epsilon_2=0$ ($\partial\phi/\partial n=0$) ф-лы (2) дают решение родственной группы разл. физ. задач о потенц. обтекания границы (в данном случае плоской) непроницаемого препятствия, роль к-рого в магнитостатике играет сверхпроводник, в токовой статике — изолятор, в гидродинамике — твёрдое тело. С помощью конечной системы изображений могут быть построены также решения аналогичных задач обтекания для тел более сложной формы (сфера, нек-рые овалоиды), внесённых в однородный на бесконечности поток.

Для перем. полей, описываемых волновым ур-нием (в электродинамике, акустике и т. д.), И. м. позволяет получить точное решение задачи лишь в случае плоской границы, на к-рой проекция поля или потенциалов удовлетворяют граничным условиям простейшего вида ($\phi=0$ или $\partial\phi/\partial n=0$). В частности, легко решается задача о поле перем. электрич. диполя над идеально проводящей плоскостью. Искомое поле создаётся данным диполем [с моментом $p(t)$] и его зеркальным изображением [с